

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 17, DE 28 DE JANEIRO DE 2014

Altera o PPB para os produtos COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSE OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS, produzidos no País.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, INTERINO e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 4º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 16 a 19 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no Processo MDIC no 52000.016749/2007-57, de 15 de outubro de 2007, resolvem:

Art. 1º Os Processos Produtivos Básicos para os produtos COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSE OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS, produzidos no País, estabelecidos pela Portaria Interministerial MCT/MICT no 201, de 13 de novembro de 2007, passam a ser conforme os artigos seguintes.

Art. 2º COMPONENTES SEMICONDUTORES e DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS:

I - corte da lâmina (wafer);

II - montagem e fixação da pastilha não encapsulada (die);

III - soldagem dos fios ou dos contatos de solda no substrato;

IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;

V - corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid Array) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicável;

VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small-Outline Packages) ou similar, quando aplicável;

VII - corte ou singularização, quando aplicável;

VIII - testes (ensaios) elétricos, funcionais e de caracterização ou testes optoeletrônicos;
e

IX - marcação (identificação).

§ 1º Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora no País.

§ 2º Os circuitos integrados projetados no País, nos termos da Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ficam dispensados de realizar a etapa constante do inciso I do caput. § 3º As etapas descritas no caput aplicam-se aos dispositivos semicondutores das posições 85.41 e 85.42 da NCM.

§ 4º As etapas descritas no caput aplicam-se aos dispositivos semicondutores da posição 8523.51 da NCM, que utilizem a tecnologia de montagem mediante o processo chip on board (COB) diretamente em substrato, com exceção das etapas V e VI.

§ 5º Fica dispensado o cumprimento da etapa descrita no inciso I, por um prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação desta portaria interministerial.

Art. 3º COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO:

I - processamento físico-químico sobre o substrato;

II - montagem dos componentes sobre o substrato, quando aplicável;

III - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e

IV - marcação (identificação).

Parágrafo único. Para a produção de circuitos integrados híbridos, ficam dispensados de atender ao disposto no caput do art. 2º desta Portaria os componentes semicondutores utilizados como insumos na produção dos mesmos.

Art. 4º CÉLULAS FOTOVOLTAICAS:

I - processamento físico-químico referente às etapas de difusão, texturização e metalização;

II - corte da lâmina; e

III - teste (ensaio).

Art. 5º MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS:

I - corte da lâmina (wafer);

II - montagem e fixação da pastilha não encapsulada (die);

III - soldagem dos fios ou dos contatos de solda no substrato;

IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;

V - corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid Array) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicável;

VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small-Outline Packages) ou similar, quando aplicável;

VII - corte ou singularização, quando aplicável;

VIII - testes (ensaios) elétricos, funcionais e de caracterização;

IX - marcação (identificação);

X - montagem e soldagem dos componentes na placa de circuito impresso;

XI - gravação da memória do tipo Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - EEPROM ou do circuito integrado controlador; e

XII - testes elétricos, funcionais e etiquetagem para identificação dos módulos, quando aplicável.

§ 1º As etapas constantes dos incisos de I a X deste artigo poderão ser dispensadas em até 2% (dois por cento) do total de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendário.

§ 2º Poderão ser utilizados circuitos integrados monolíticos do tipo memória de acesso aleatório (Random Access Memory - RAM) importados num percentual máximo de, até, 20% (vinte por cento) na montagem local dos MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendário.

§ 3º Adicionalmente ao § 2º, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos circuitos integrados do tipo memória importados utilizados na montagem dos MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS deverão ser marcados e testados no Brasil.

§ 4º A obrigatoriedade estabelecida no § 3º poderá ser dispensada caso a empresa fabricante opte por utilizar circuitos impressos produzidos conforme seu respectivo Processo Produtivo Básico num percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de todas as placas de circuitos impressos utilizadas na produção de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS, no ano-calendário.

§ 5º Caso o percentual dos §§ 1º a 4º não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano subsequente, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 6º A diferença residual a que se refere o § 5º não poderá exceder a 5% (cinco por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido. § 7º Fica dispensado o cumprimento da etapa descrita no inciso I, por um prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação desta portaria interministerial.

§ 1º Os projetos de P&D executados pelas empresas deverão estar enquadrados nas áreas estratégicas e prioritárias do Programa Brasil Maior, definidas para o setor de tecnologias da informação e comunicação e estar alinhados com a estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação.

§ 2º A aprovação prévia dos projetos pela Suframa não implica em aceitação automática nos mesmos.

§ 3º A Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA será responsável pelo acompanhamento da execução dos projetos.

§ 4º Os resultados da execução dos projetos serão comprovados quando da apresentação do Relatório Demonstrativo Anual de que trata o Art. 29 do Decreto no 6.008, de 2006.

§ 5º Para efeito da aplicação dos investimentos em P&D adicionais, serão considerados como aplicação em pesquisa e desenvolvimento do ano-calendário, os dispêndios correspondentes à execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas até 31 de março do ano subsequente.

§ 6º Todas as demais condições deverão estar em conformidade com Lei no 8.387/1991 e suas alterações, e Decreto no 6.008/2006.

Art. 6º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim, o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO SCHAEFER

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Interino

MARCO ANTONIO RAUPP

A Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação